

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0207U004217

Державний реєстраційний номер: 0106U009492

Відкрита

Дата реєстрації: 06-02-2007



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка нових напівпровідникових матеріалів на основі шаруватих кристалів та дослідження їх радіаційної стійкості в умовах ядерних випромінювань

Початок етапу: 04-2006

Закінчення етапу: 12-2006

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Чернівецьке відділення Інститут проблем матеріалознавства НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540043

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Адреса: 58001, м.Чернівці, вул.І.Вільде, 5

Телефон: 52-51-55, 52-00-50

Інше: 3-60-18

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Чернівецьке відділення Інститут проблем матеріалознавства НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540043

Адреса: 58001, м.Чернівці, вул.І.Вільде, 5

Підпорядкованість: Національна академія наук України

Телефон: 52-51-55, 52-00-50

E-mail: chimsp@unicom.cv.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК:

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка нових напівпровідникових матеріалів на основі шаруватих кристалів та дослідження їх радіаційної стійкості в умовах ядерних випромінювань.

Назва роботи (англ)

Development of new semiconductor materials based on layered crystals and investigation of their radiation resistance under nuclear irradiation.

Реферат (укр)

Виготовлені дослідні зразки на основі гетероструктур типу ITO - GaSe, власний оксид- InSe, p-n-InSe, p-GaSe-n-InSe. Проведено комплексні дослідження цих матеріалів та їх електрофізичних характеристик до і після опромінення.

Реферат (англ)

Experimental samples of ITO-GaSe, intrinsic oxide-InSe, p-n-InSe, and p-GaSe-n-InSe are manufactured. Complex investigations of these materials and their electrical characteristics before and after irradiation are carried out.

Індекс УДК: 544.33;541.341/.344;544.34, 621.315.592

Коди тематичних рубрик НТІ: 31.15.25

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

1.Kovalyuk Z.D., Katerynychuk V.M., Politanska O.A., Sydor O.M., Savchuk A.I., Raransky M.D., and Palamaryk M.Yu. Change of heterostructures contact potential difference induced by X-ray irradiation // Nuclear Instruments and Methods in Physics. B. - 2006. - Vol. 246. - p. 118-121.2.Ковалюк З.Д., Катеринчук В.Н., Политанская О.А., Раранский Н.Д. Характеристики гетеропереходов окисел-р-InSe в условиях рентгеновского облучения // ФТП. - 2006. - Т. 40. - № 8. - С. 926-929. 3.Kovalyuk Z.D., Politanska O.A., Maslyuk V.T. Radiative stability of InSe-diodes irradiated with fast electrons // Abstracts of the 3rd international conference on materials science and condensed matter physics, - Chisinau, Moldova, October 2-6, 2006, p. 239.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 155

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості

Перелік організацій-співвиконавців

Назва організації: ІПМ ім. І.М.Францевича НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270

Адреса: 03142, Київ, Кржижанівського, 3

Підпорядкованість:

Назва організації: МНТСП "Центр електронного матеріалознавства та прикладних проблем авіакосмічної техніки"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24748157

Адреса: 03142, Київ, Кржижанівського, 3

Підпорядкованість:

Назва організації: НДК "Прискорювач", ННЦ Харківський фізико-технічний інститут"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 14312223

Адреса: 61108, Харків, вул. Академічна, 1

Підпорядкованість:

Керівник організації:

Ковалюк Захар Дмитрович

Керівники роботи:

Ковалюк Захар Дмитрович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.